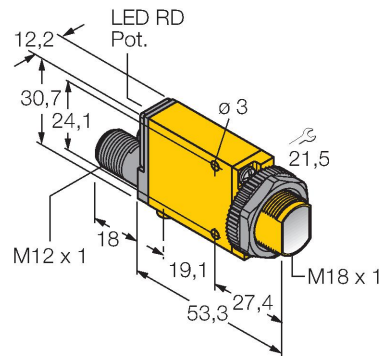


SM31EMHSQD

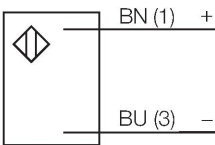
Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (излучатель)



Свойства

- Вилка, M12 x 1, 4-конт.
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 10...30 В =

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	SM31EMHSQD
ID №	3029268
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	0...3000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 25 мА
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.3 мс
Параметр настройки	Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, Mini Beam
Размеры	Ø 18 x 71.3 x 12.3 x 30.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Acrylic
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Герметизированный

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях.

Коэффициент усиления
Зависимость коэффициента усиления от расстояния

